









	<p>DMJ70H600SH3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: DMJ70H600SH3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Diodes Incorporated</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET BVDSS: 651V 800V TO251</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Datenblätter:  DMJ70H600SH3.pdf</p>
	<p>RoHS Status: Enthält Blei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	DMJ70H600SH3
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET BVDSS: 651V 800V TO251
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-251
Serie	Automotive, AEC-Q101
Rds On (Max) @ Id, Vgs	600 mOhm @ 2.4A, 10V
Verlustleistung (max)	113W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3, IPak, Short Leads
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Hersteller Standard Vorlaufzeit	8 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	643pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18.2nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	700V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 700V 11A (Tc) 113W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A (Tc)

DMJ70H600SH3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMJ70H600SH3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMJ70H600SH3 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ DMJ70H600SH3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>DMJ70H1D3SJ3 Diodes Incorporated MOSFET N-CH TO251</p>	 <p>DMJ70H601SK3-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CHANNEL 700V 8A TO252</p>	 <p>DMJ70H1D5SV3 Diodes Incorporated MOSFET N-CHANNEL 700V 5A TO251</p>	 <p>DMJ70H601SV3 Diodes Incorporated MOSFET N-CHANNEL 700V 8A TO251</p>
 <p>DMJ70H900HJ3 Diodes Incorporated MOSFET BVDSS: 651V 800V TO251</p>	 <p>DMJ70H1D3SH3 Diodes Incorporated MOSFET BVDSS: 651V 800V TO251</p>	 <p>DMJ70H1D4SV3 Diodes Incorporated MOSFET N-CHANNEL 700V 5A TO251</p>	 <p>DMJ70H1D3SI3 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 700V 4.6A TO251</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DMJ70H600SH3 Diodes Incorporated	DMJ70H600SH3 Datenblatt	DMJ70H600SH3-Datenblätter	DMJ70H600SH3 PDF	Diodes Incorporated DMJ70H600SH3
DMJ70H600SH3 Electronic	DMJ70H600SH3-Komponenten	DMJ70H600SH3-Verteiler	DMJ70H600SH3-Bild	DMJ70H600SH3-Teil
DMJ70H600SH3 Preis	DMJ70H600SH3 Hersteller	DMJ70H600SH3 Bild	DMJ70H600SH3 Aktie	DMJ70H600SH3 Inventar
DMJ70H600SH3 Neu	DMJ70H600SH3 Original	DMJ70H600SH3 garantiert	DMJ70H600SH3 RFQ	DMJ70H600SH3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited